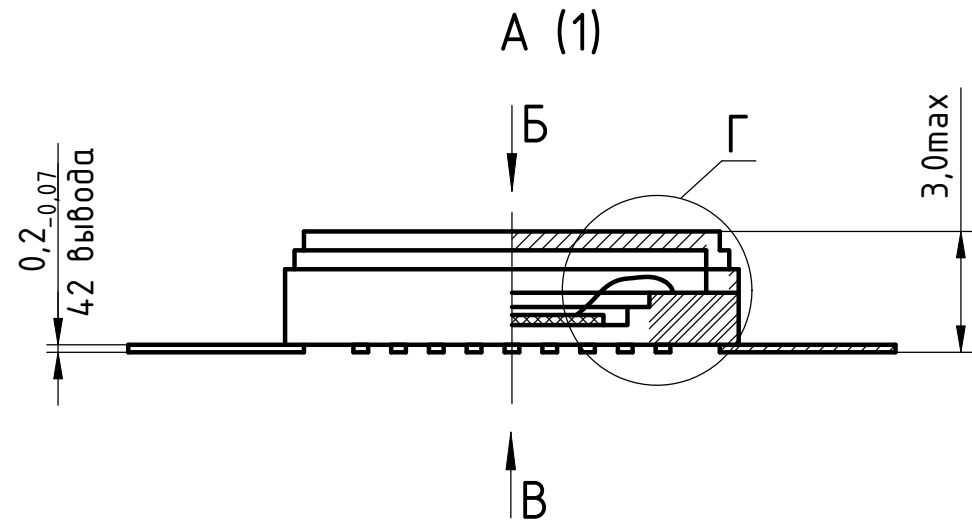


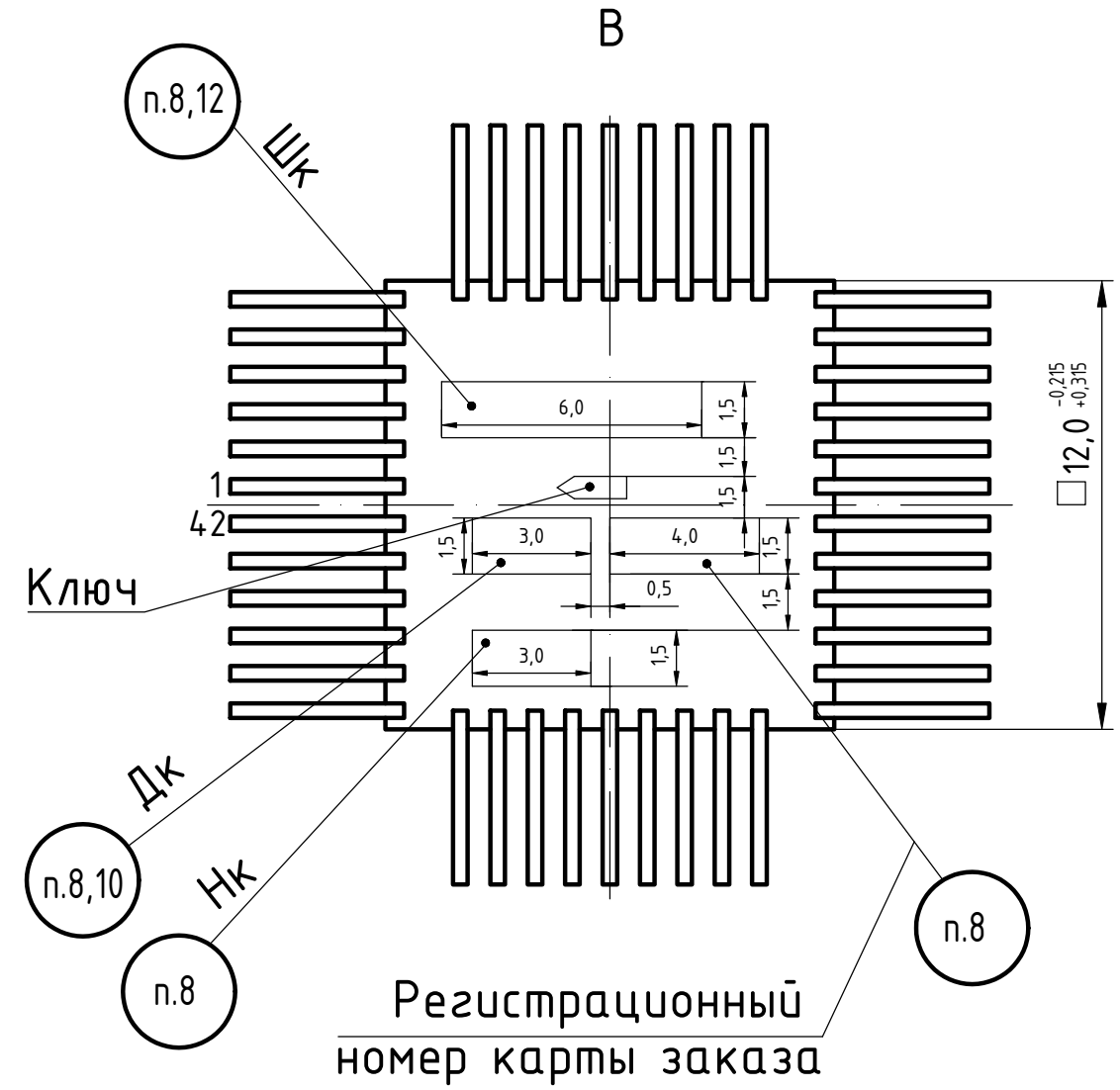
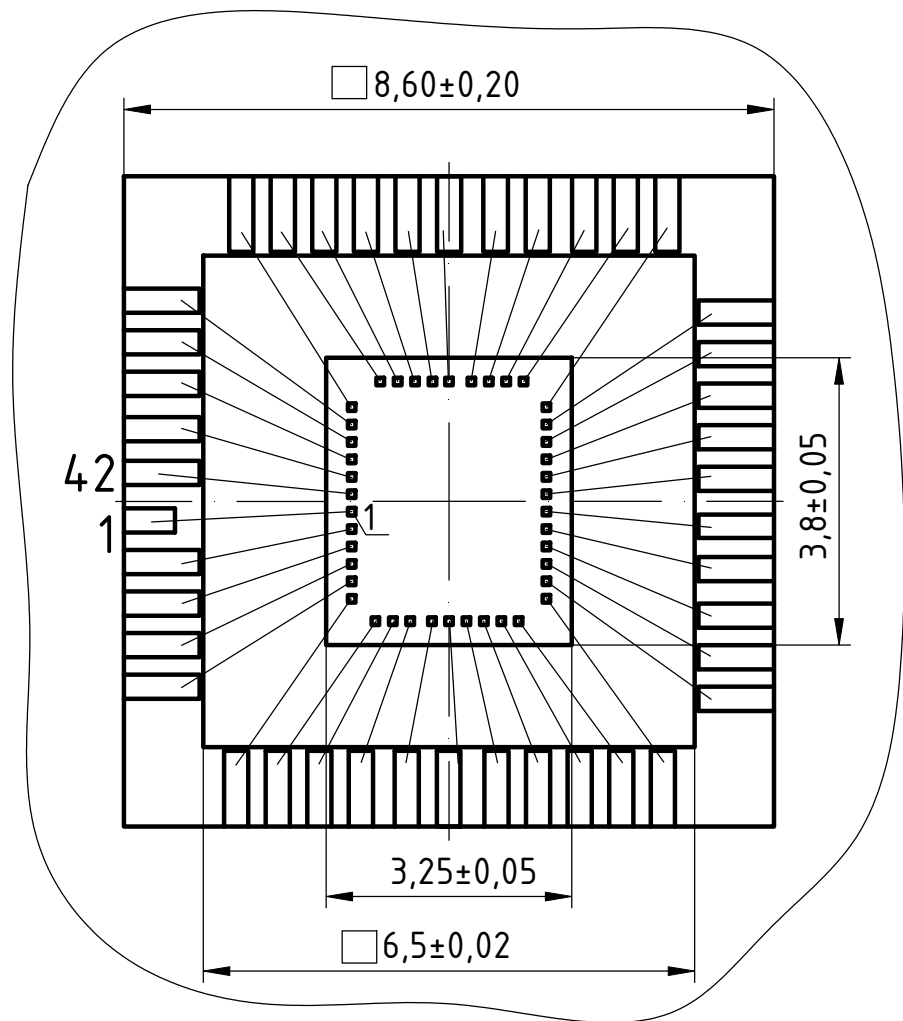
1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
- 3.Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
- 4.Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д – максимальная стрела прогиба проводника.
- 5.Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
- 6.Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$.
- 7.Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида ОК0.347.273Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, знак Δ согласно основному виду.
9. С обратной стороны маркировать согласно виду В.
10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
11. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
12. В зоне Шк маркировать обозначение изделия "Н5503ХМ2".
13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
14. Допускается нанесение клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
15. Нумерация выводов приведена условно.
16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии соответствует данным этикетки Г АВЛ.431260.019ЭТ.

					Г АВЛ.431260.019СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Микросхемы интегральные Н5503ХМ2 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Астахова					А	max 3,0 г	5:1
Пров.	Тикашкин					Лист 1 Листов 4		
Т.контр.	Терпигорева							
Н.контр.	Васильев							
Утв.	Денисов							

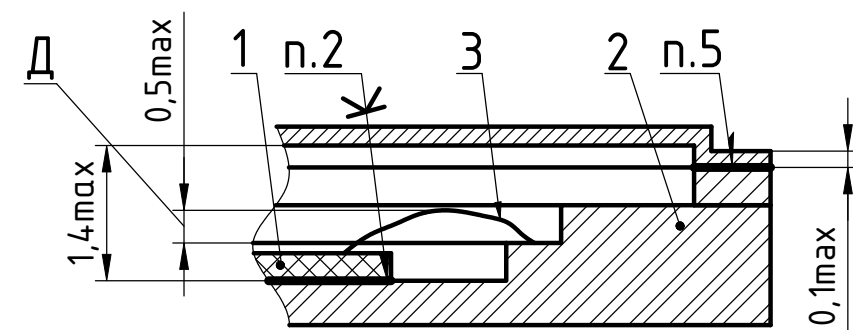


Б (10:1)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны



Г (10:1)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	ГВЛ.431260.019СБ	Лист
						2